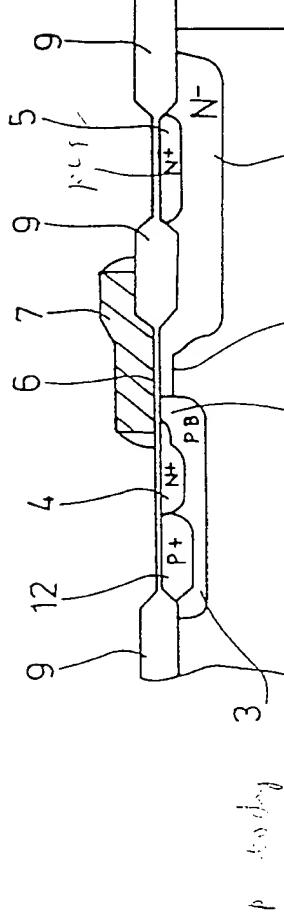
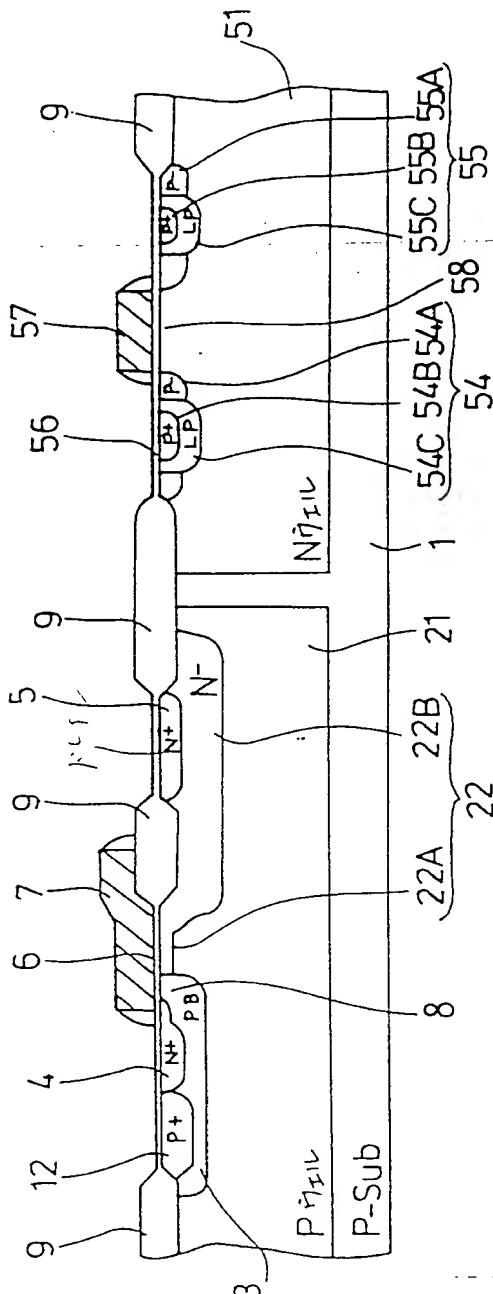


FIG.1

(A)



(B)



21: P型ゲート領域

22A: 第1のN-層
22B: 第2のN-層
22: N-層 (P+層+N+層)

51: N型ゲート領域

54,55: P型拡散領域

56: P+トネル絶縁膜

57: P+電極

58: キャメル領域

提出日 平成10年12月10日

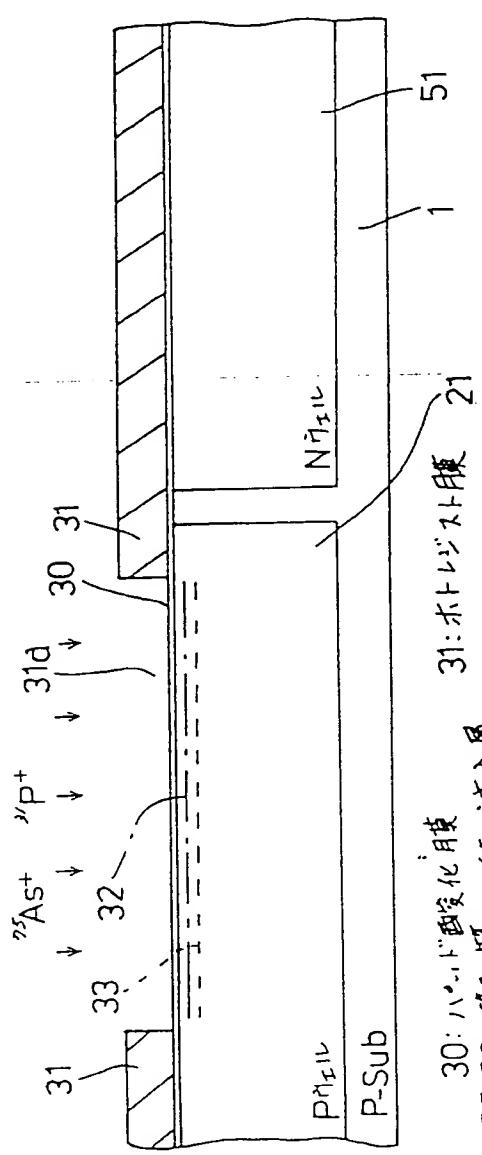
整理番号=KIA0980196

1/22

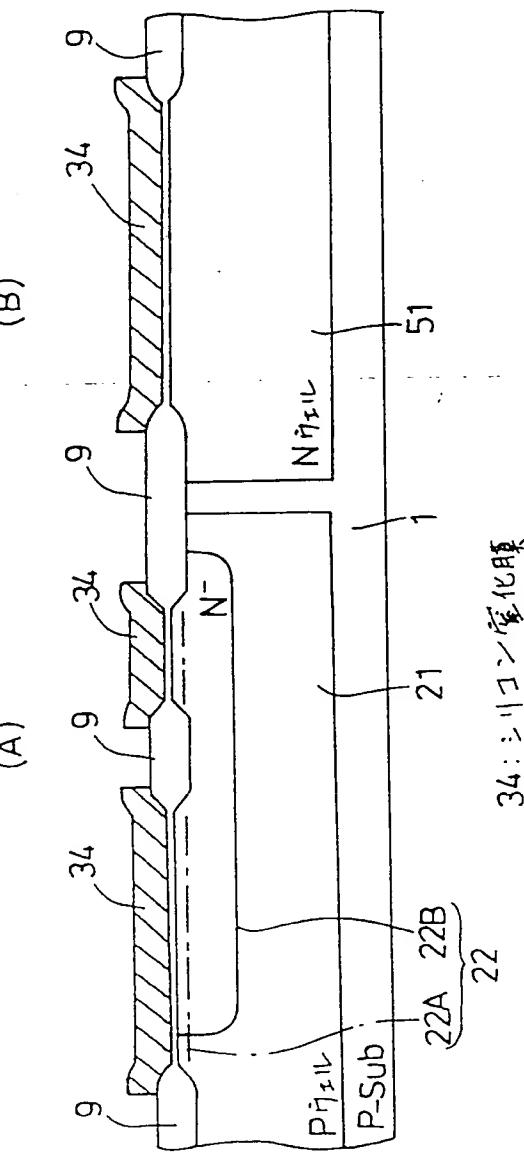
2/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=KIA0980196

FIG. 2A

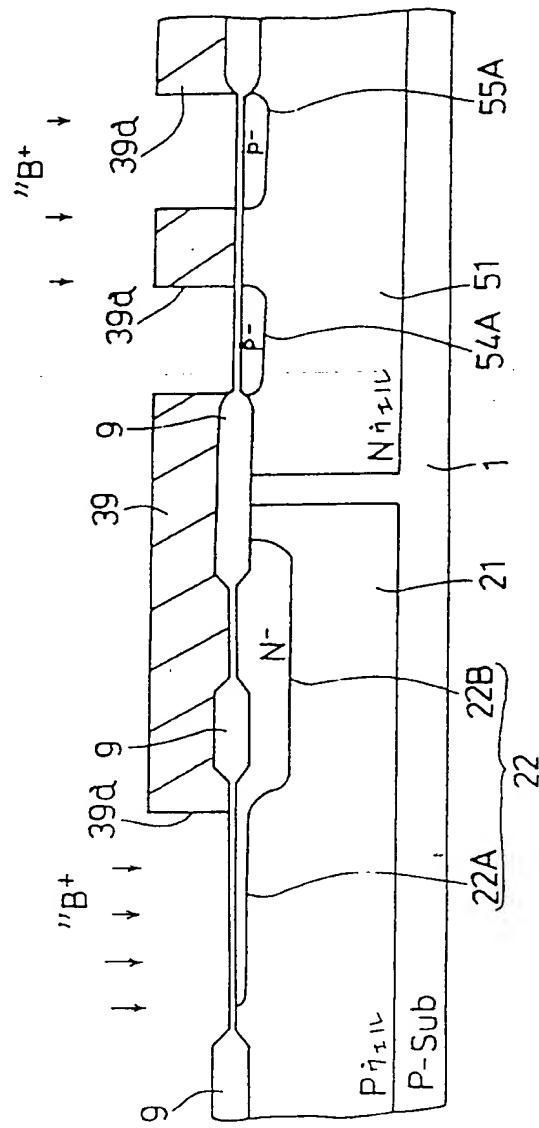
(A)

**FIG. 2B**

3/22

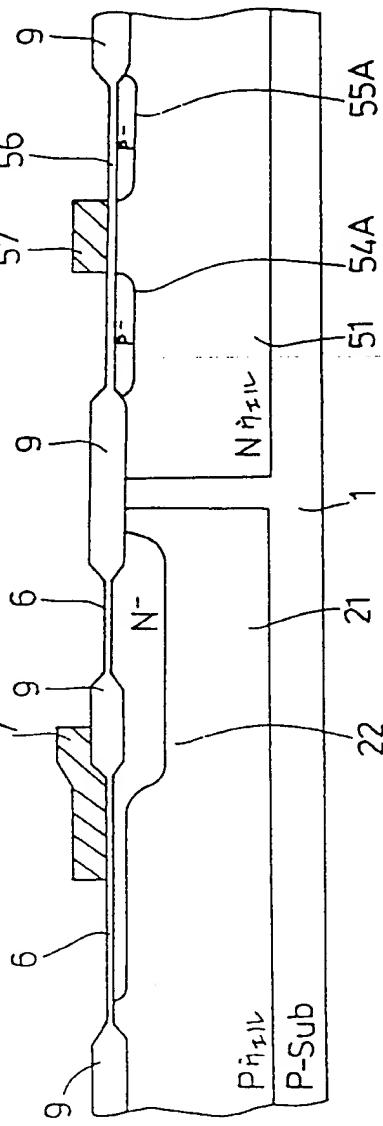
提出日 平成10年12月10日

整理番号=KIA0980196



39ドットレスストラップ

(A)



(B)

FIG. 3B

4/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=KIA0980196

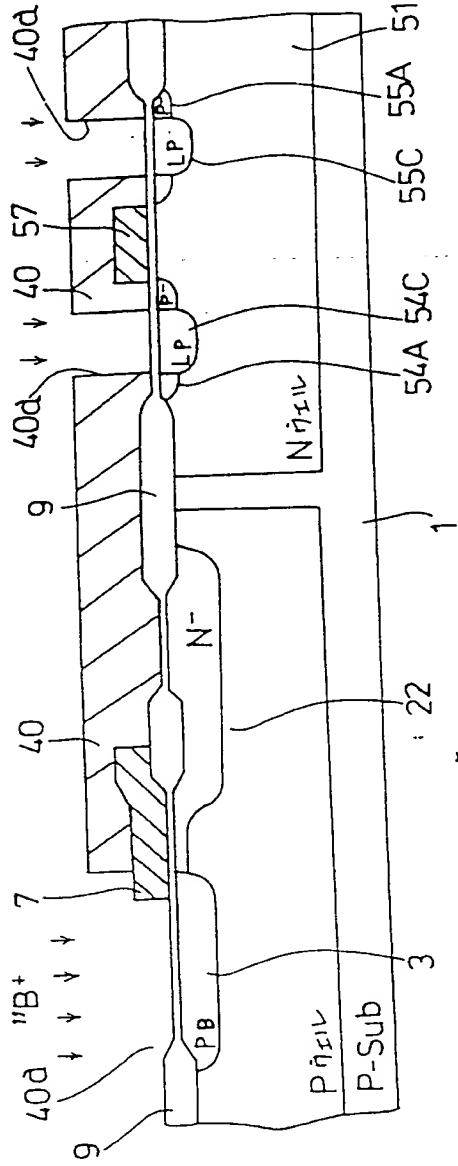


FIG.4A

(A) 40: ホトレジスト膜

(A)

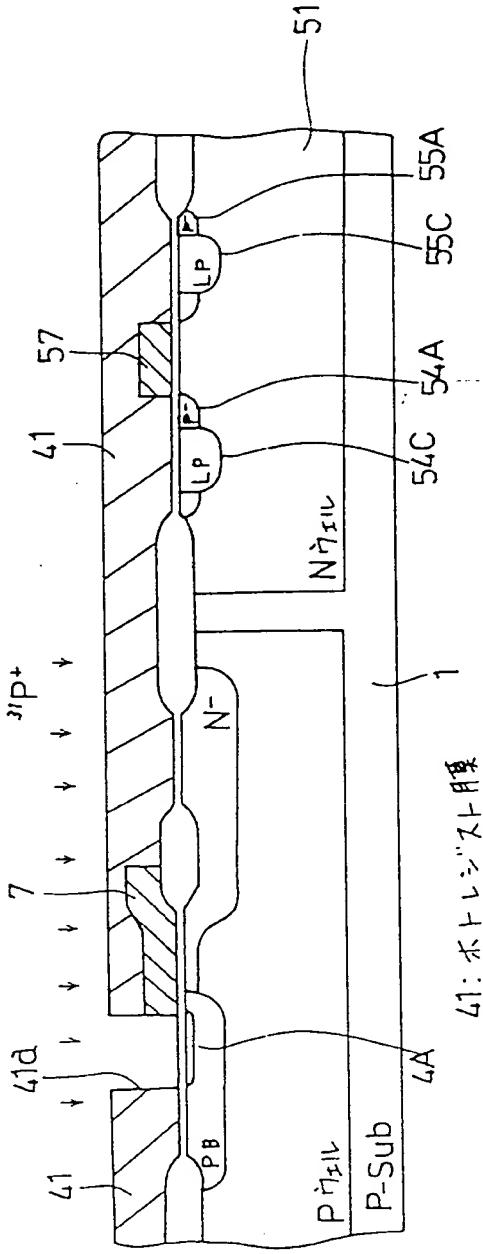


FIG.4B

41: ホトレジスト膜

5/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=KIA0980196

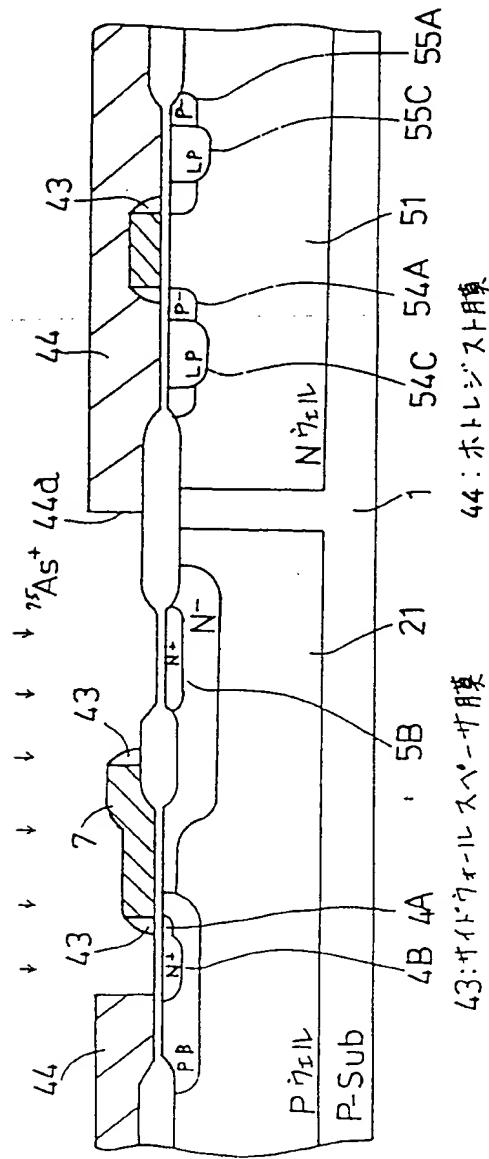


FIG.5A

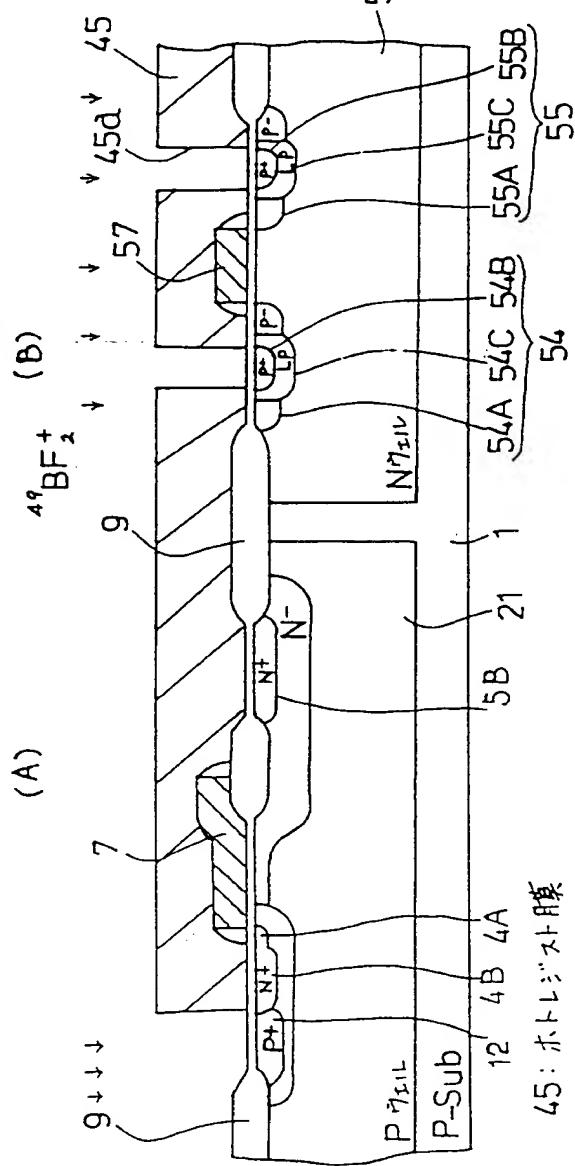


FIG.5B

6/22

提出日 平成 10 年 12 月 10 日

整理番号 = KIA0980196

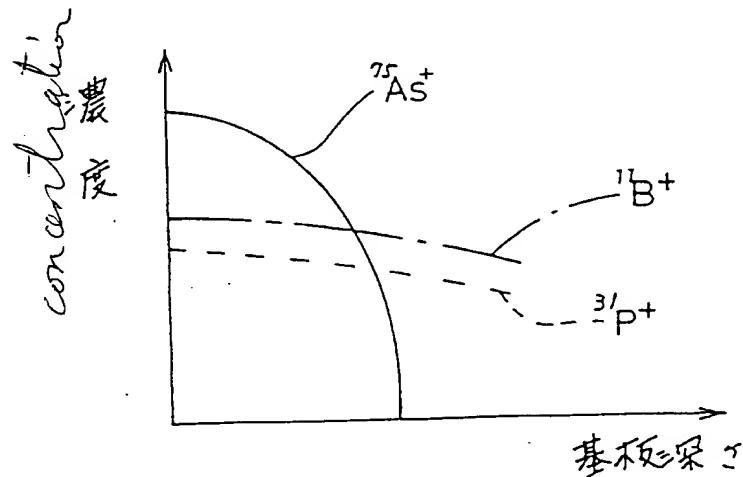


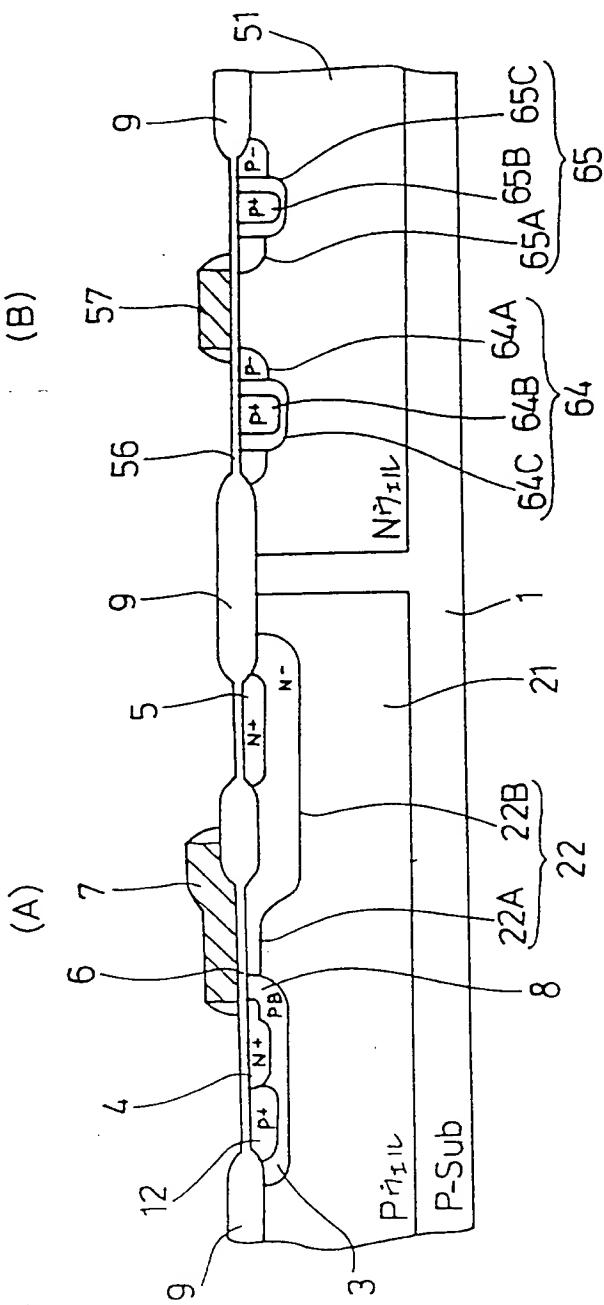
FIG.6

7/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=KIA0980196

FIG.7



64,65: リース・ドライン領域

8/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

【書類名】 図面

【図1】

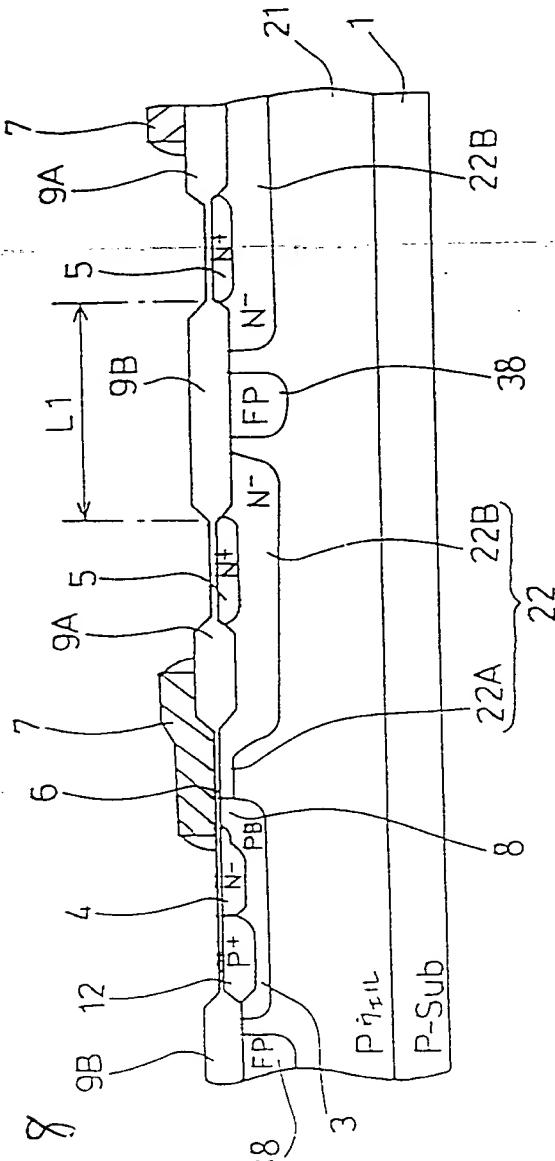


FIG. 8

21: P型"ナレル領域

22A: 第1のN-層

22B: 第2のN-層
22: N-層(ドリット領域)

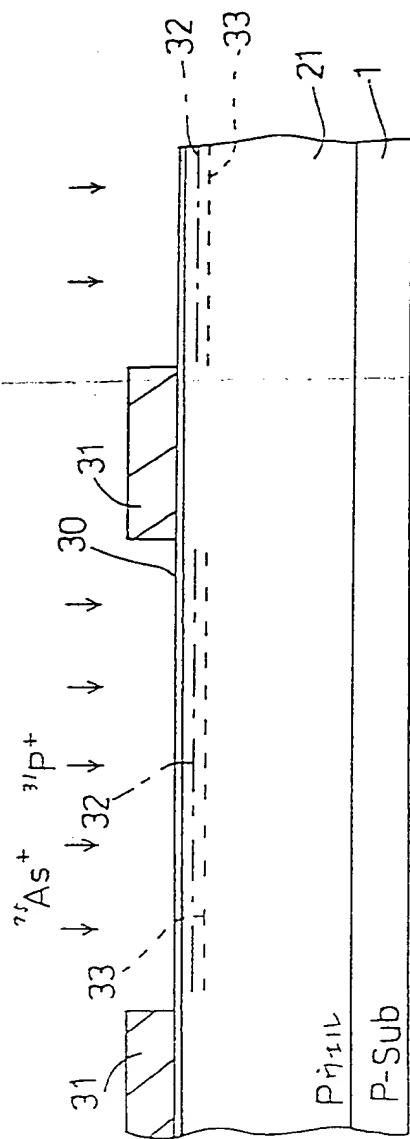
38: ナネルスラッシュ層

9/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

FIG.9



30: 11° ド面格化用
31: 第1, 第2の注入層
32,33: 第1, 第2の注入層

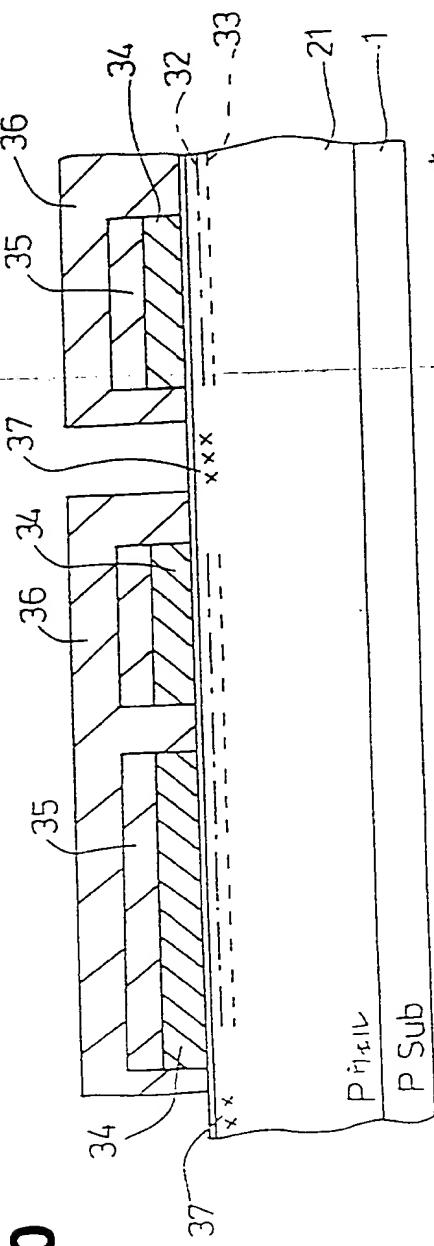
10/22

施主日 平成10年12月 4日

登録番号=KIA0980186

10

FIG.10



35, 36: 第1, 第2の木トレリ注入層

37: ハルストン 180° 層 形成用オーナメント

11/22

提出日 平成10年12月4日

登録番号=K I A 0 9 8 0 1 8 6

//

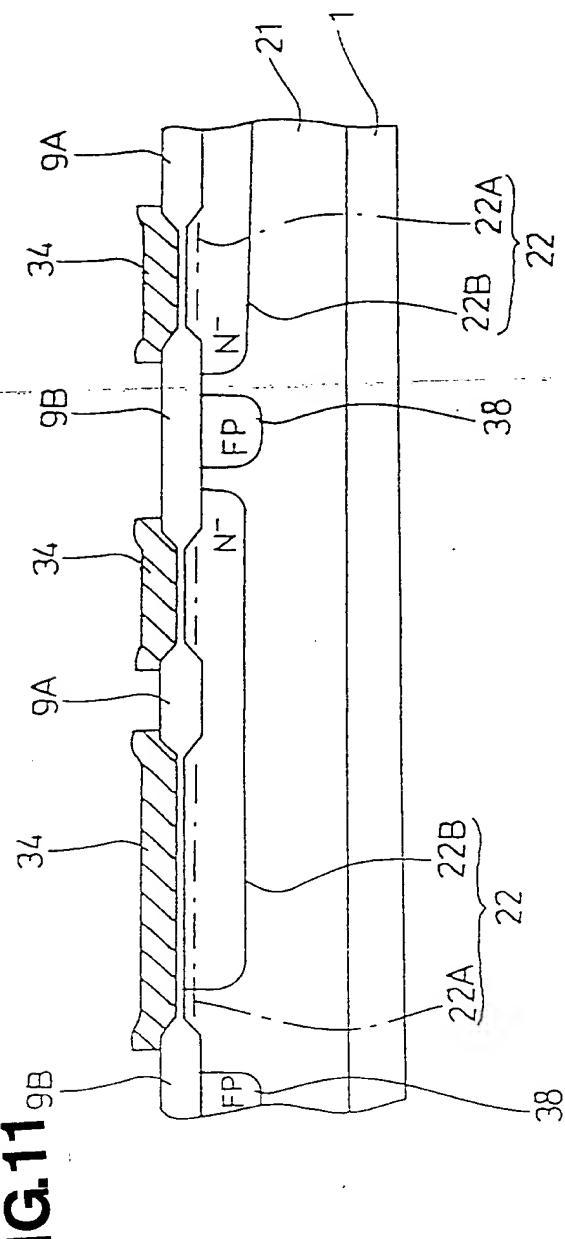


FIG.11

11

日本特許公報

12/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

72

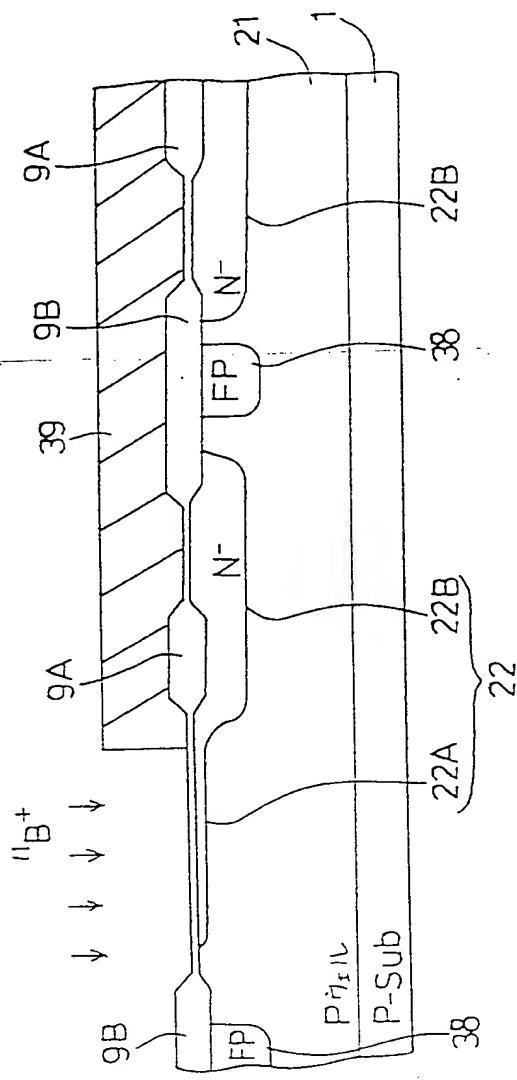


FIG.12

39: フォトマスク上膜

13/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

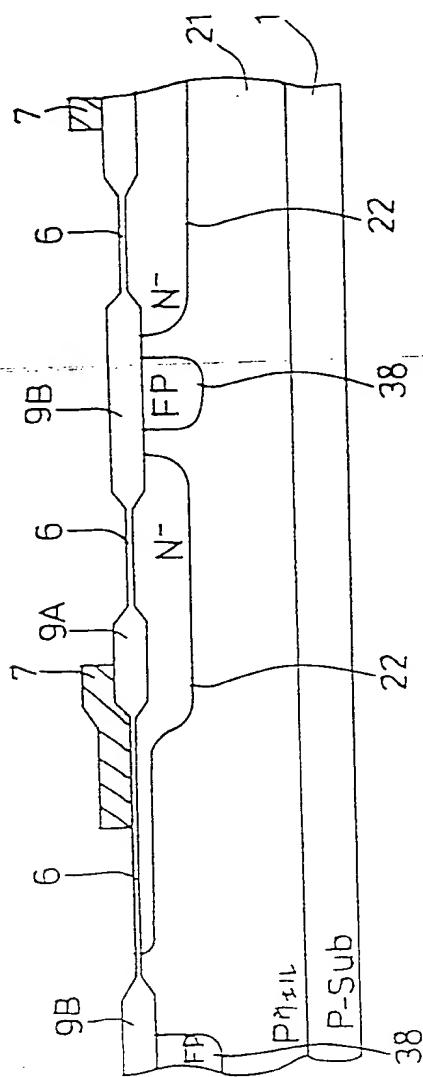


FIG.13

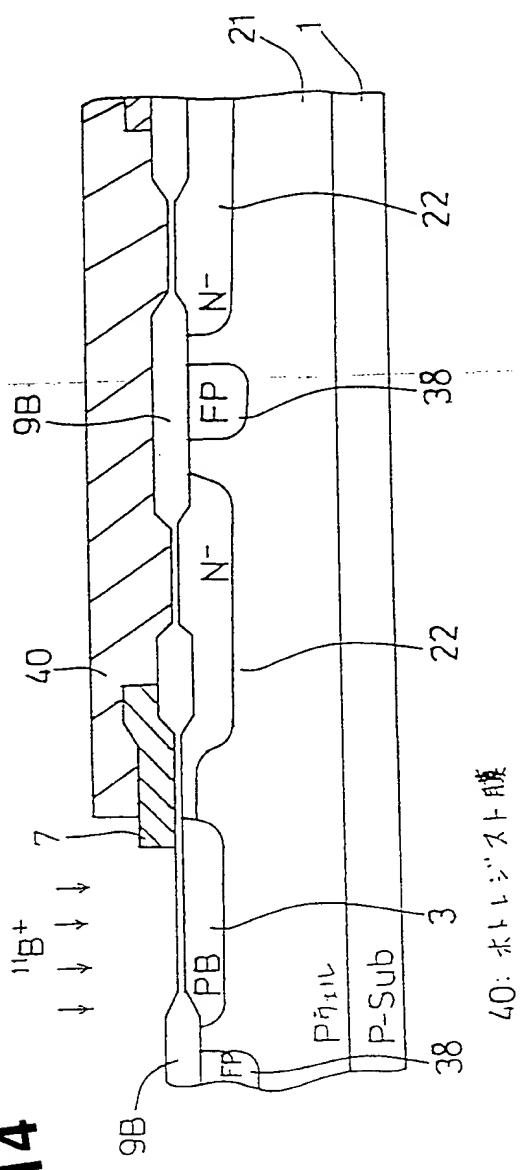
14/22

提出日 平成10年12月4日

整理番号=KIA0980186

1/2

FIG.14

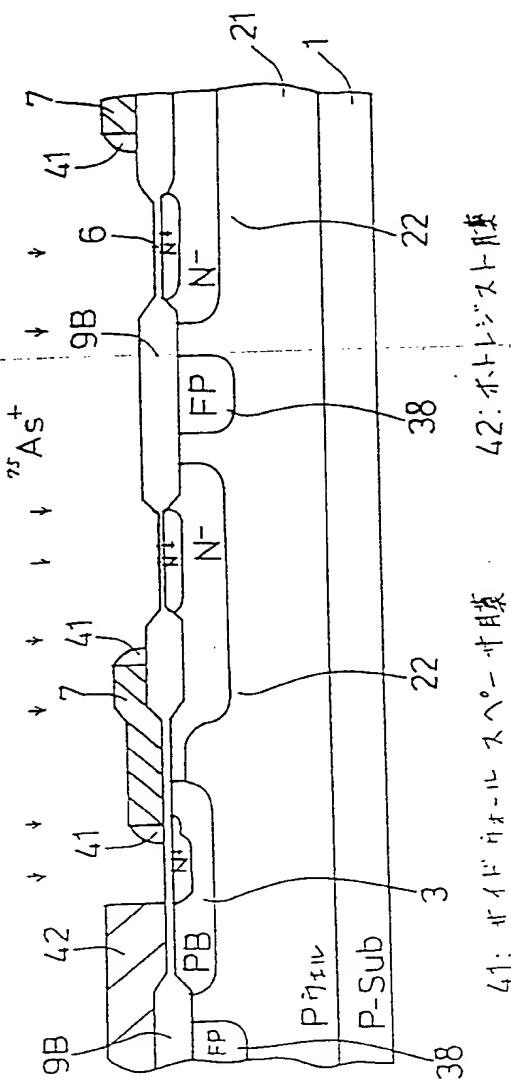


15/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

FIG.15



41: フォトマスク
42: フォトマスク

42: フォトマスク

16/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

16

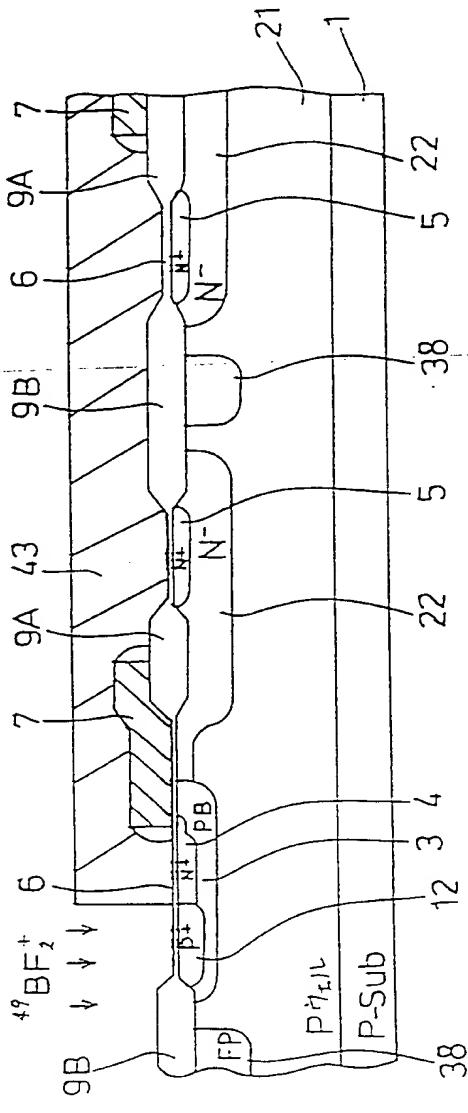


FIG. 16

43: ホトレジスト膜

17/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

17

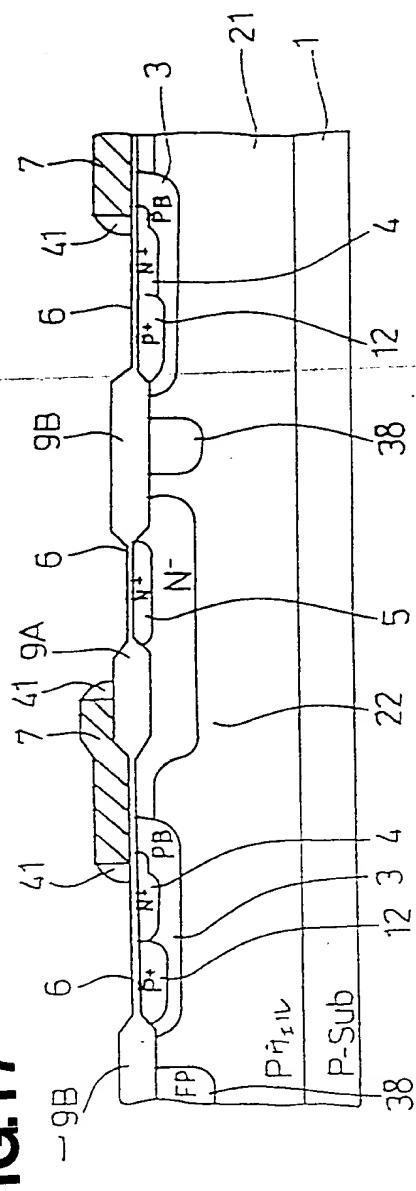


FIG. 17

18/22 提出日 平成10年12月10日

整理番号=KIA0980196

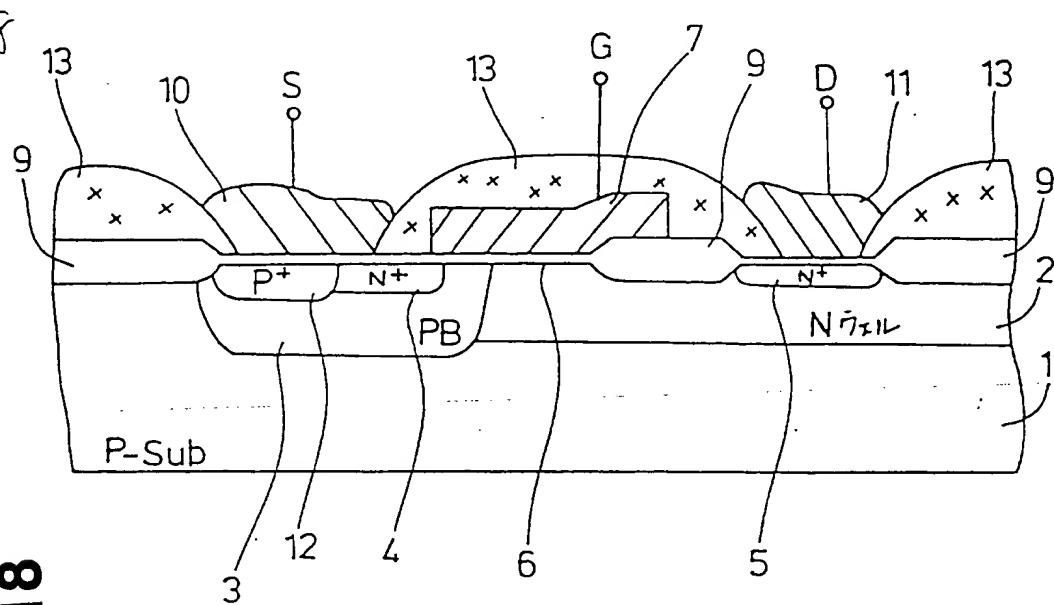
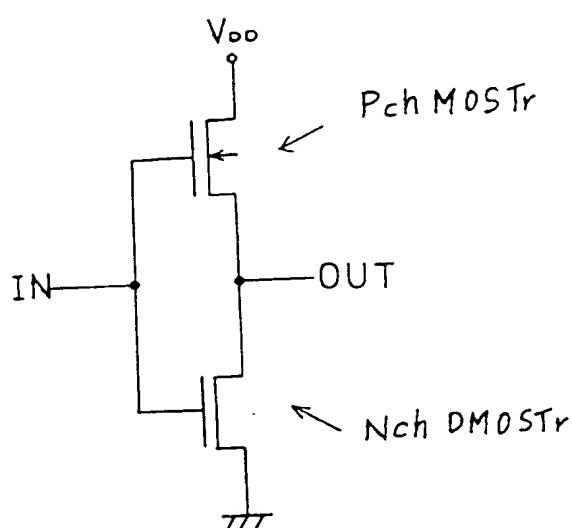
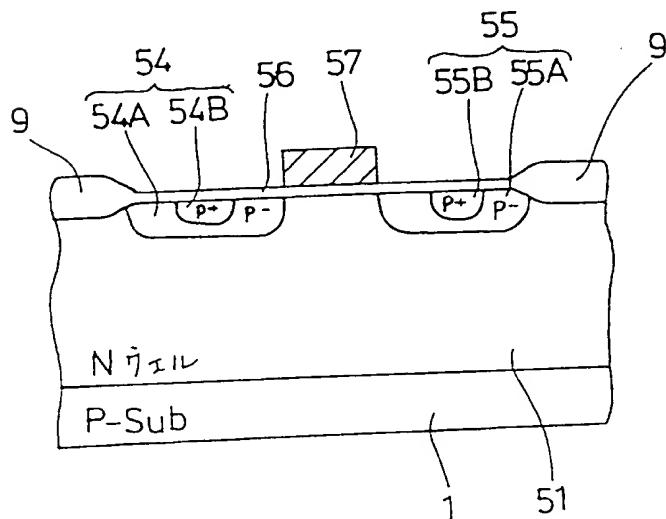


FIG. 18

19/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=KIA0980196

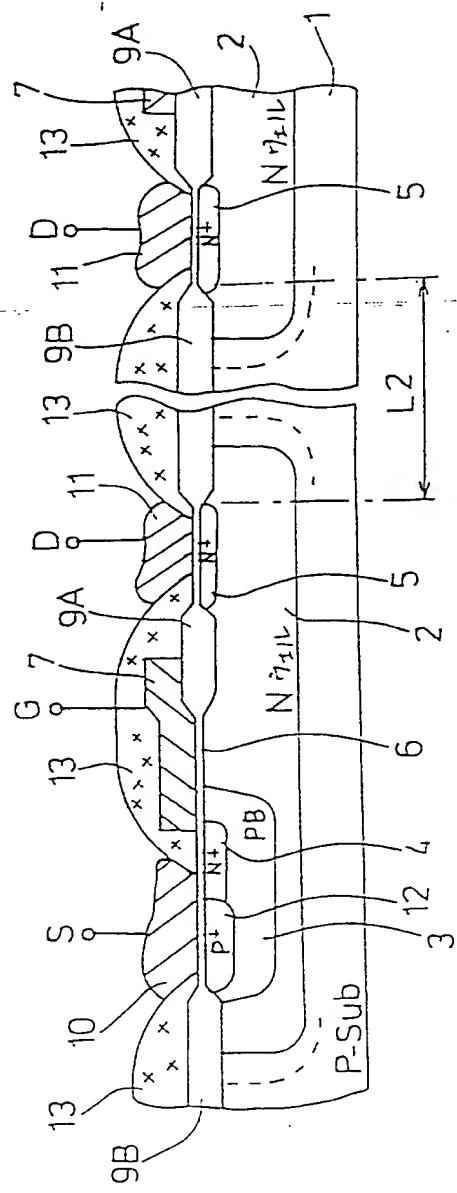
FIG.19A**FIG.19B**

20/22

提出日 平成10年12月4日

整理番号=KIA0980186

[図12]



21/22

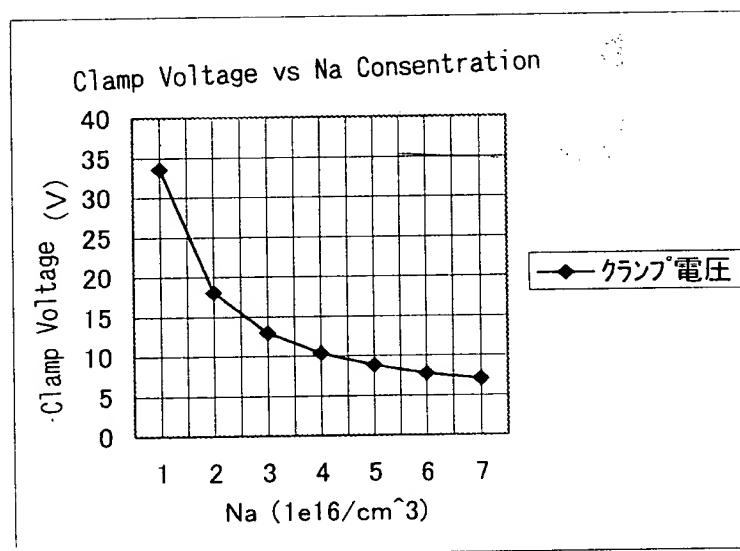


FIG.21

N - Clamp Voltage vs Na Concentration

Stepped Junction N - Concentration $1 \times 10^{17} / cm^3$

$X_j = 0, 2 \mu m$

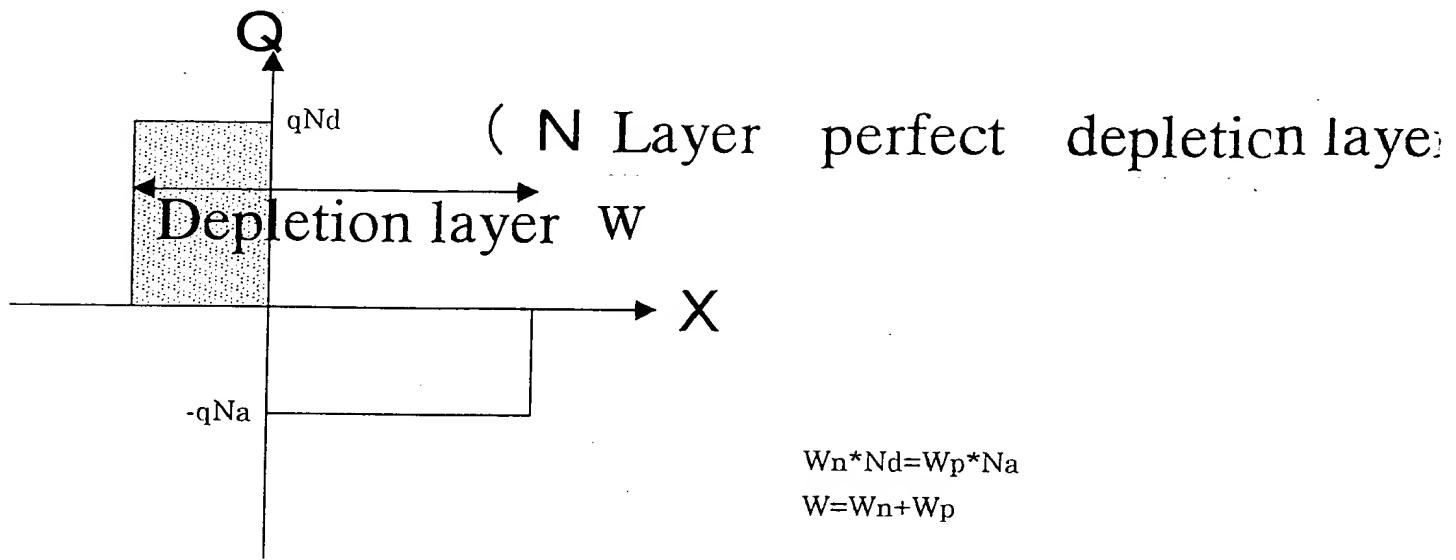
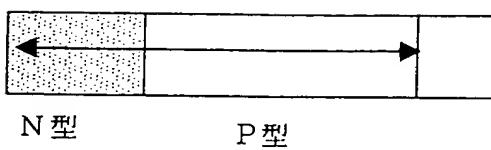


Fig.22 Stepped Junction